



마이크로파 이중 대역 위상 변환기

2022년 8월 22일

전북대학교대학원

전자정보공학부

김 수 연

마이크로파 이중 대역 위상 변환기

Microwave Dual-band Phase Shifter

2022년 8월 22일

전북대학교대학원

전자정보공학부

김 수 연

마이크로파 이중 대역 위상 변환기

Microwave Dual-band Phase Shifter

지도교수 정용채

이 논문을 공학 석사 학위논문으로 제출함.

2022년 4월 19일

전북대학교대학원

전자정보공학부

김 수 연

김 수 연의 석사학위논문을 인준함.

위 원 장	전북대학교 부교수	임 동 구 (인)
부위원장	전북대학교 교수	이 지 훈 (인)
위 원	전북대학교 교수	정 용 채 (인)

2022년 7월 5일

전북대학교대학원

- 목	차	—
-----	---	---

ABSTRACT

1.	서语	<u> </u>	1
----	----	----------	---

2. 반사형 위상 변환기의 이론 4

3. 이중 대역 위상 변환기를 위한 반사 부하

3.1. 주파수에 따른 varactor 다이오드 비선형성 83.2. 동작 주파수에 따른 반사 부하

- 3.2.1. 낮은 주파수 동작 15
- 3.2.2. 높은 주파수 동작 17
- 3.3. 설계 순서도 19

4. 이중 대역 위상 변환기의 설계 및 측정

4.1. 위상 주파수 설계

- 4.1.1. 낮은 주파수 동작 23
- 4.1.2. 높은 주파수 동작 27
- 4.2. 위상 변환기의 시뮬레이션 및 측정 결과 31
- 5. 고찰 및 선행 연구 결과 비교 39
- 6. 결론 41

참고문헌

- 그 림 목 차 -

그림 2.1. 일반적인 반사형 위상 변환기의 구조 4 그림 3.1. 인가전압에 따른 낮은 주파수 대역에서의 커패시턴스 변화 9 그림 3.2. 인가전압에 따른 높은 주파수 대역에서의 커패시턴스 변화 9 그림 3.3. SMV-1231 varactor 다이오드의 등가모델 10 그림 3.4. 낮은 주파수 대역에서 인가전압에 따른 커패시턴스 값 11 그림 3.5. 높은 주파수 대역에서 인가전압에 따른 커패시턴스 값 11 그림 3.6. 낮은 주파수 대역에서의 위상 변환 범위 12 그림 3.7. 높은 주파수 대역에서의 위상 변환 범위 12 그림 3.8. Varactor 다이오드의 등가회로 14 그림 3.9. 동작 주파수에 따른 반사 부하의 구조: (a) 낮은 주파수 동작, (b) 높은 주파수 동작 13 그림 3.10. 낮은 주파수 동작에서의 보상 방법 15 그림 3.11. 높은 주파수 동작에서의 보상 방법 17 그림 3.12. 반사 부하의 알고리즘 순서도 19 그림 4.1 낮은 대역 동작에서 $\lambda/4$ 개방 스터브의 스미스 차트 23 그림 4.2. 보상소자가 없을 때 낮은 대역 동작 ADS 시뮬레이션: (a) 위상 특성. (b) 반사 손실 특성 24 그림 4.3 낮은 대역 동작 ADS 시뮬레이션: (a) 회로, (b) 위상 특성, (c) 반사 손실 특성 26

그림 4.4. 높은 대역 동작에서 $\lambda/4$ 개방 스터브의 스미스 차트 27
그림 4.5. 보상소자가 없을 때 높은 대역 동작 ADS 시뮬레이션: (a) 위상
특성, (b) 반사 손실 특성 28
그림 4.6. 높은 대역 동작 ADS 시뮬레이션: (a) 회로, (b) 위상 특성, (c)
반사 손실 특성 30
그림 4.7. 제안한 위상 변환기의 회로 31
그림 4.8. 제작된 위상 변환기의 사진 32
그림 4.9. 낮은 대역 동작의 시뮬레이션 및 측정 결과: (a) 위상 특성, (b)
삽입 손실 특성, (c) 반사 손실 특성 34
그림 4.10. 높은 대역 동작의 시뮬레이션 및 측정 결과: (a) 위상 특성,
(b) 삽입 손실 특성, (c) 반사 손실 특성 36
그림 4.11. 이중 대역 동작의 시뮬레이션 및 측정 결과: (a) 위상 특성,
(b) 삽입 손실 특성, (c) 반사 손실 특성

- 표 목 차 -

표	4.1.	낮은	대역	동작	반사	부하	의 피	라다	기터	계산	결과	•••••	•••••	•••••	25
표	4.2.	높은	대역	동작	반사	부하	의 피	라며	기터	계산	결과				29
표	4.3.	제안	한 위⁄	상 변화	환기으	물리]적 :	치수	와 소	는자 i	값	•••••			32
표	4.4.	낮은	대역	동작	시시]뮬레	이션	및	측정	결과		•••••			34
표	4.5.	높은	대역	동작	시시]뮬레	이션	및	측정	결과		•••••			36
표	4.6.	이중	대역	동작	시시]뮬레	이션	및	측정	결과		•••••			38
표	5.1.	선행	연구	결과의	와 제	안된	위상	변혁	환기의	1 성	등 비	교.			40

ABSTRACT

Microwave Dual-band Phase Shifter

Su-Yeon Kim Division of Electronics and Information Engineering The Graduate School Jeonbuk National University

In this research, the reflection-type dual-band tunable phase shifter is designed. The proposed phase shifter is reflection-type structure that provides high return loss and low insertion loss characteristics. The phase shifting range and in-band phase deviation of reflection load using equivalent circuit of varactor diode is studied and reflection loads according to operating frequency is presented.

Proposed phase shifter consists to 3-dB hybrid coupler and same two reflection load. The reflection load consists to $\lambda/4$ transmission line, $\lambda/4$ open-circuited stub, compensation element and varactor diode. The parasitic element of $\lambda/4$ open-circuited stub is compensated by inductor or capacitor that selected according to frequency. To verify the proposed design method, reflection-type dual-band tunable phase shifter operating at 1.88 GHz and 2.44 GHz, and 100 MHz of bandwidth is designed. From simulated. and measured. the measurement results, the proposed phase shifter achieves dual-band operation independently, low in-band phase deviation and high return loss characteristic.

Keyword : $\lambda/4$ open-circuited stub, Dual-band, Phase deviation, Phase shifting range.

1. 서론

무선 통신 시스템의 중요한 구성 요소 중 하나인 위상 변환기는 빔 형 성, 위상 배열 안테나, 그리고 다중입력 다중출력 시스템에서 널리 이용되 고 있다[1]-[5]. 최근 다중대역 신호를 하나의 어플리케이션으로 처리하기 위해 연속적으로 조정 가능한 다중대역 위상 변환기가 많이 요구되고 있 다.

조정 가능한 위상 변환기는 가변선로형, 전송선로형, 메타물질 구조, 반 사형으로 크게 나눌 수 있다. 가변선로형 위상 변환기는 스위치와 전송선 로로 간단하게 구성되어 있으며, 스위치의 ON/OFF 상태에 따라 원하는 위상을 얻을 수 있다[6]. 하지만 넓은 위상 변환 범위 또는 위상 변환 간 격을 좁히기 위해서는 스위치의 증가로 인한 전체 회로의 크기 증가가 요 구된다. 이를 해결하기 위해 전송선로형과 메타물질 구조가 이용된다. 전 송선로형은 높은 임피던스를 갖는 전송선로에 연결된 varactor diode 또 는 PIN diode를 통해 연속적인 위상 변환을 얻을 수 있으며[7] 메타물질 구조는 메타물질 구조에 포함된 커패시터를 varactor diode로 대체하여 선형적인 위상 변환 특성을 얻을 수 있다[8]. 하지만 이 두 구조는 커패시 턴스의 변화에 따른 전체 회로의 임피던스가 변하게 되어 부정합의 문제 가 발생하게 된다.

반사형 위상 변환이기는 3-dB Hybrid 결합기와 동일한 두 개의 반사 부하로 구성되며, 반사 손실 특성이 좋아 가변 위상 변환이기에 많이 이 용되고 있다. 먼저 임피던스 변환 쿼드러쳐 결합기를 이용한 가변 위상 변환기가 제시되었다[9]. 제안된 구조는 반사 부하에 varactor 다이오드를 cascade로 연결하여 최대 407°의 넓은 위상 변환 범위를 갖지만, 최대 4.6 dB의 큰 삽입 손실 특성을 보인다. [10]에서는 반사 부하가 하나의 전송 선로와 1개 또는 3개의 varactor 다이오드로 구성되어있는 L- 또는 π-형 태의 위상 변환이기를 보여주고 있으며 200 MHz의 대역폭 내에서 각각 201°와 385°의 위상 변환 특성을 보여주고 있다. 비슷하게, 브랜치 선로 결합기에 전송선로, varactor 다이오드 그리고 성능을 위한 션트 개방 스 터브가 연결되는 구조가 제안되었다[11]. 제안된 구조는 1 GHz의 넓은 대 역폭 내에서 190°의 위상 변환 범위, ± 10°로 낮은 대역 내 위상 편차 특 성을 보인다. [12]에서는 수직 평면 구조를 적용한 위상 변환기가 제안되 었다. 이 논문에서는 결합 선로를 수직 평면 구조로 구현하였으며, 350°의 넓은 위상 변환 범위를 구현하였지만, 대역 내 위상 편차가 ± 100°으로 매우 크다. 전송선로가 이용된 반사 부하를 이용하여 500 MHz의 광대역 에서 146.9°의 위상 변환 범위와 ±5.79°의 적은 대역 내 위상 편차를 갖는 구조도 제안되었다[13].

하지만 전형적인 위상 변환기는 단일 대역에서만 동작한다는 한계를 갖 고 있어 최근에는 다중 대역에서 동작하는 위상 변환기가 요구된다. [14] 에서는 CMOS 공정을 이용한 다중대역 위상 변환기가 제안되었지만 상 대 주파수에 영향을 주며 독립적인 동작은 불가하였다. 반면에 [15]에서는 독립적으로 동작하는 이중 대역 위상 변환기도 제안되었지만, 화합물 공 정을 이용하여 제작에 어려움이 있다. 이처럼 가변 위상 변환기의 설계에 는 위상 변환 범위, 위상 편차 그리고 삽입 및 반사 손실 등과 같이 많은 특성을 고려해야 한다.

본 논문에서는 이중 대역에서 동작하는 반사형 위상 변환기를 설계하였 으며, varactor 다이오드를 이용하여 인가전압에 따른 선형적인 위상 변환 특성을 나타내었다. 또한, 동작 주파수와 협동 주파수의 관계에 따른 분석 을 통해 적절한 보상 소자를 선택하였다. 설계를 위해 제안된 반사 부하 의 위상 식을 유도하고, 순서도를 통해 원하는 성능을 얻을 수 있는 설계 파라미터를 구할 수 있다. 제안된 설계를 검증하기 위해 이중 대역 위상 변환기를 제작 및 측정했다. 설계된 이중 대역 위상 변환기는 1.88 GHz와 2.44 GHz의 두 중심 주파수에서 위상 변환 범위가 각각 114.134°와 114.017°이며, 100 MHz의 대역폭 내 위상 편차는 최대 ±9.465°와 ±6.076° 의 특성을 나타낸다. 또한, 두 대역 내에서 반사 손실은 각 19.669 dB와 16.684 dB이상이며 삽입 손실은 각 1.867 dB와 1.983 dB이하의 특성을 보 인다.

본 논문의 전체적인 구성은 다음과 같다. 2장에서는 반사형 위상 변환 기의 동작 원리와 각 동작 주파수에서 반사 부하에 따른 위상 식을 확인 했다. 3장에서는 varactor 다이오드의 등가회로를 이용한 회로 분석을 통 해 반사 부하의 위상 변환 범위와 대역 내 위상 편차를 수식적으로 확인 하였으며 원하는 성능을 얻을 수 있는 설계 순서도를 제시하였다. 4장에 서는 제안한 반사 부하를 적용한 이중 대역 위상 변환기를 설계 및 제작 하여 시뮬레이션과 측정 결과를 비교했으며 5장에서 선행연구와 비교를 통해 고찰했다. 마지막으로 6장에서는 연구 결과에 대한 결론을 맺었다.

2. 반사형 위상 변환기의 이론

일반적인 반사형 위상 변환기는 그림 2.1과 같이 3-dB 하이브리드 결합 기와 반사 부하로 구성되어 있다. 결합기의 결합 단자와 통과 단자에는 동일한 반사 부하가 연결되는데, 반사 부하가 리액턴스 성분만 갖는다면 두 부하에서 발생하는 반사에 의한 위상 변환을 통해 신호 진폭의 변화는 없이 입력 단자 간의 위상만을 조정할 수 있다. 이때 위상 변환기에서 얻 을 수 있는 위상 변환 범위는 반사 부하에서 발생하는 위상 변환 범위와 동일한 특성을 갖게 된다. 이는 특정 단자를 종단하여 측정된 산란 매트 릭스로부터 *n*-단자 산란 매트릭스를 구하는 방법인 port reduction method를 통해 설명할 수 있다. 또한, 입력 단자로 반사 부하의 반사된 신호는 결합기를 지나며 역위상이 되어 서로 상쇄되기 때문에 입력 단자 에서의 반사 손실 특성이 뛰어나다는 장점이 있다.

본 논문에서는 port reduction method를 통해 3 단자와 4 단자가 동일 한 두 반사 부하로 종단된 위상 변환기의 2 단자 산란 매트릭스를 구할 수 있다. 또한, 이를 통해 일반적인 반사형 위상 변환기의 위상 특성을 수 식적으로 구할 수 있다.



Fig 2.1. Typical structure of reflection type phase shifter.

측정된 산란 매트릭스는 4 단자 3-dB 하이브리드 결합기로 식 (2.1)과 같이 나타낼 수 있다. 이 결합기는 간단하게 1 단자와 2 단자 그리고 3 단자와 4 단자의 쌍으로 분리할 수 있다. 분리된 회로는 식 (2.2)와 같이 나타낼 수 있고, 행렬식은 식 (2.3)으로 나타낼 수 있다.

$$S_{o} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & j \\ 0 & 0 & j & -1 \\ -1 & j & 0 & 0 \\ j & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$
(2.1)
$$S_{11_{o}o} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, S_{21_{o}o} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 & j \\ j & -1 \end{bmatrix}, S_{12_{o}o} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 & j \\ j & -1 \end{bmatrix}, S_{22_{o}o} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$
(2.2)
$$\begin{cases} b_{1} = S_{11_{o}o}a_{1} + S_{12_{o}o}a_{2} \\ b_{2} = S_{21_{o}o}a_{1} + S_{22_{o}o}a_{2} \end{bmatrix}$$
(2.3)

그림 1과 같이 3 단자와 4 단자가 입력 임피던스가 Z_L인 동일한 반사 부하로 종단되어 있을 때 두 단자의 반사 계수를 *I*_L로 나타낸다면 반사 부하의 산란 매트릭스는 식 (2.4)와 식 (2.5)로 나타낼 수 있다.

$$S_{L} = \begin{bmatrix} \Gamma_{L} & 0\\ 0 & \Gamma_{L} \end{bmatrix}$$
(2.4)
$$b' = S_{L}a'$$
(2.5)

이때, 3 단자와 4단자로 입사되는 입사파인 a_2 는 반사 부하의 반사파인 b'으로 볼 수 있고, 3 단자와 4단자로 반사되는 반사파인 b_2 는 반사 부하 의 입사파인 a'으로 볼 수 있다. 따라서 식 (2.5)는 식 (2.6)과 같이 나타 낼 수 있다.

$$a_2 = S_L b_2$$
 (2.6)

식 (2.6)을 식 (2.3)에 대입하면 식 (2.7)과 같이 나타낼 수 있고, 식 (2.3)을 a_1 과 b_1 에 대해 정리하면 식 (2.8)과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{cases} b_1 = S_{11_o} a_1 + S_{12_o} S_L b_2 \\ b_2 = S_{21_o} a_1 + S_{22_o} S_L b_2 \end{cases}$$
(2.7)

- 5 -

$$\frac{b_1}{a_1} = S_{11_o} + S_{12_o} S_L \left(U - S_{22_o} S_L \right)^{-1} S_{21_o}$$
(2.8)

식 (2.8)에 해당하는 파라미터를 대입하면, 기존 4 단자 회로의 산란 매 트릭스를 새로운 2 단자 회로의 산란 매트릭스로 다음과 같이 정리할 수 있다.

$$S_{2-port} = \begin{bmatrix} 0 & -j\Gamma_L \\ -j\Gamma_L & 0 \end{bmatrix}$$
(2.9)

신호의 진폭에 변화 없이 위상만을 조정하기 위해 반사 부하가 리액턴 스 성분만을 갖는다고 가정하면, *Z*_L=*jX*_L과 같이 나타낼 수 있고, 반사 계 수 *Γ*_L, 위상 *φ*_L 그리고 위상 변환 범위 Δ*φ*_L은 식 (2.10)처럼 나타낼 수 있다. 이때, *x*_L은 정규화된 반사 부하의 리액턴스를 의미하며, *x*_{L,max}와 *x*_{L,min}은 가변 반사 부하의 최대와 최소 리액턴스의 값을 의미한다.

$$\Gamma_{L} = \frac{jX_{L} - Z_{0}}{jX_{L} + Z_{0}} = \frac{jx_{L} - 1}{jx_{L} + 1}$$

$$\phi_{\Gamma_{L}} = \tan^{-1} \left(\frac{x_{L}}{-1}\right) - \tan^{-1} \left(\frac{x_{L}}{1}\right) = -2\tan^{-1} \left(x_{L}\right)$$

$$\Delta \phi_{\Gamma_{L}} = \left|-2\tan^{-1} \left(x_{L,\max}\right) + 2\tan^{-1} \left(x_{L,\min}\right)\right| \qquad (2.10)$$

식 (2.10)에서 구한 Γ_L을 이용해 Z_L의 동일한 두 반사 부하로 종단된 위상 변환기의 1 단자와 2 단자 사이의 위상 φ와 위상 변환 범위 Δφ는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{1}{x_L} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{x_L}{1} \right) = \frac{\pi}{2} - 2 \tan^{-1} \left(x_L \right)$$
$$\Delta \phi = \left| -2 \tan^{-1} \left(x_{L,\max} \right) + 2 \tan^{-1} \left(x_{L,\min} \right) \right|$$
(2.11)

식 (2.10)과 식 (2.11)에서 볼 수 있듯이 반사 부하의 위상 변환 범위 Δ Φ 과 전체 회로의 위상 변환 범위 ΔΦ는 동일한 것을 알 수 있다. 따라서 반사 부하의 설계에 따라 전체 위상 변환기의 원하는 위상 변환 범위 특 성을 얻을 수 있다.

반사 부하가 리액턴스 성분 중 캐패시턴스 성분만을 갖는다고 하면, 주

파수 *f*와 가변 캐패시턴스 *C*_V에 의해 결정된다고 볼 수 있다. 결과적으로 위상 *φ*는 *f*와 *C*_V에 대한 함수로 나타낼 수 있다.

$$\phi(f, C_V) = \frac{\pi}{2} - 2 \tan^{-1}(x_L(f, C_V))$$
(2.12)

식 (2.12)로부터 C_V 의 최소 캐패시턴스 $C_{V,min}$ 에서 최대 캐패시턴스 $C_{V,max}$ 까지의 변화에 따른 동작 주파수에서의 위상 변환 범위를 식 (2.13) 과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{cases} \Delta \phi(C_{V}) \Big|_{f_{o}} = \phi(C_{V}) \Big|_{f_{o}} - \phi(C_{V,\min}) \Big|_{f_{o}} \\ \text{when } \phi(C_{V,\min}) \Big|_{f_{o}} < \phi(C_{V,\max}) \Big|_{f_{o}} \\ \Delta \phi(C_{V}) \Big|_{f_{o}} = \phi(C_{V}) \Big|_{f_{o}} - \phi(C_{V,\max}) \Big|_{f_{o}} \\ \text{when } \phi(C_{V,\min}) \Big|_{f_{o}} > \phi(C_{V,\max}) \Big|_{f_{o}} \end{cases}$$
(2.13)

또한, 동작 대역폭 내 위상 편차 ϕ_{dev} 는 식 (2.14)와 같이 표현될 수 있다.

$$\phi_{dev}(C_V) = \max\left(\Delta\phi(C_V)\big|_{BW}\right) - \min\left(\Delta\phi(C_V)\big|_{BW}\right)$$
(2.14)

3. 이중 대역 위상 변환기를 위한 반사 부하

3.1. 주파수에 따른 varactor 다이오드 비선형성

일반적으로 가변 위상 변환기의 반사 부하에는 잡음으로 인한 전력손실 이 적은 varactor 다이오드를 주로 사용한다. Varactor 다이오드는 P-N 접합 다이오드로 역 바이어스를 인가하여 공핍 영역의 폭을 제어할 수 있 고, 이를 통해 캐패시턴스 변화를 제어할 수 있다. 따라서 varactor 다이 오드를 반사 부하에 적용해 리액턴스를 제어할 수 있고, 인가되는 전압으 로 위상 특성을 조절할 수 있다. 그렇지만 varactor 다이오드의 기생 성분 으로 인해 주파수에 따라 일정하지 않은 커패시턴스 혹은 인덕턴스 성분 을 갖게 되는데 이는 대역 내 위상 편차의 증가를 일으킬 수 있다.

위상 특성에서 주파수에 따른 varactor 다이오드의 비선형성이 어떠한 영향을 끼치는지 Keysight 사에서 제공하는 Advanced Design System (ADS) 시뮬레이션을 통해 확인해 보았다. ADS에서 제공하는 다이오드 모델과 실제 varactor 다이오드의 측정 결과를 추출하여 비슷한 특성을 보일 수 있도록 다이오드 모델 파라미터를 수정하여 등가 회로를 구성하 였고, 이를 통해 ADS 시뮬레이터를 통해 전압에 따른 주파수 비선형성을 확인할 수 있다.

Varactor 다이오드는 Skyworks 사의 SMV-1231을 사용하였다. 동작 주파수는 각각 1.88 GHz와 2.44 GHz이고, Network analyzer를 이용하여 0V부터 16V까지의 전압 인가에 따른 커패시턴스를 측정했다. SMV-1231 은 동일 제품군 중 최소 커패시턴스 값이 가장 작아 리액턴스에 따라 반 사 부하의 비교적 넓은 위상 변환 범위를 얻을 수 있어 사용되었다. 그림 3.1과 그림 3.2는 두 동작 주파수에서 SMV-1231의 등가 모델 시뮬레이션 및 측정 결과를 비교하였고, 그림 3.3은 파라미터가 수정된 SMV-1231의 다이오드 등가 모델을 나타내고 있다.



그림 3.1. 인가전압에 따른 낮은 주파수 대역에서의 커패시턴스 변화. Fig 3.1. Variation of capacitance according to bias voltage at low-frequency band.



그림 3.2. 인가전압에 따른 높은 주파수 대역에서의 커패시턴스 변화 Fig 3.2. Variation of capacitance according to bias voltage at high-frequency band.

[
	Diode_Model							
	DIODEM1					C		
	IS=1e-014	BV=0	vjsw=			C2		
	Rs=U	IDV=0.001	FCSW=	\frown		C=0.12 pF		\frown
	Gleak-	INDV-1	AllowScaling-no					
	T+-0	Nbvl=1	Trico=	P1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		in in <mark>L</mark> andaria de la ca	P2
	Cd=	Kf=0	Xti=3	Num=1		+	L2	Num=2
	Cio=2 435 pE	Af=1	Fa=1 11		3 3 A		L=0.7689 nH	
	Vi=1.299 V	Ffe=1	AllParams=					
	M=1	Jsw=				Diada R		
	Fc=0.5	Rsw=				smy-1231 R1		
	Imax=	Gleaksw =				Model=DIODEM1 R=3 Ohm		
	Imelt=	Ns=				Area=		
	lsr=0	lkp=				Periph=		
	Nr=2	Cjsw=				Scale=		
	lkf=0	Msw=				Region=		
						Temp=		
						Trise=		
						Mode=nonlinear		

그림 3.3. SMV-1231 varactor 다이오드의 등가모델

Fig 3.3. Equivalent circuit of SMV-1231 varactor diode 그림 3.4와 그림 3.5는 다이오드 모델을 이용하여 전압에 따른 커패시턴 스 값의 변화를 100 MHz의 대역폭을 갖는 두 동작 주파수에서 나타냈다. 커패시턴스의 값은 낮은 인가전압 대역에서 큰 폭으로 변화하는 것을 볼 수 있다. 그림 3.6과 그림 3.7에서는 같은 커패시턴스 범위에서 이상적인 커패시터의 경우와 varactor 다이오드의 등가 모델을 이용한 경우의 시뮬 레이션을 통해 대역 내 위상 변환 범위를 나타내었다. 다이오드 모델의 파라미터를 단일 대역이 아닌 이중 대역에서 비슷한 특성을 나타낼 수 있 도록 수정하였기 때문에 특성의 저하가 발생하고, 이에 따라 이상적인 커 패시터와 다이오드 모델의 위상 변환 범위 및 위상 편차에서의 차이가 불 가피하다.



그림 3.4. 낮은 주파수 대역에서 인가전압에 따른 커패시턴스 값. Fig 3.4. Value of capacitance according to bias voltage at low-frequency band.



그림 3.5. 높은 주파수 대역에서 인가전압에 따른 커패시턴스 값. Fig 3.4. Value of capacitance according to bias voltage at high-frequency band.



그림 3.6. 낮은 주파수 대역에서의 위상 변환 범위. Fig 3.6. Phase shifting range at low-frequency band.



그림 3.7. 높은 주파수 대역에서의 위상 변환 범위. Fig 3.7. Phase shifting range at high-frequency band.

3.2. 동작 주파수에 따른 반사 부하

본 논문에서는 $\lambda/4$ 전송선로, $\lambda/4$ 개방 스터브, varactor 다이오드의 등 가회로 그리고 보상 소자로 구성되어 있다. Varactor 다이오드의 등가회 로는 그림 3.8에서 확인할 수 있으며 입력 어드미턴스는 식 (3.1)과 같이 구할 수 있다. 여기서, R_p , C_p , L_p 는 varactor 다이오드의 기생성분을 의미 하고, C_j 는 인가전압에 따라 달라지는 가변 커패시터를 의미한다.

$$Y_{v_{-}e} = \frac{-\omega^{2}R_{p}C_{p}C_{j} + j\omega(C_{j} + C_{p})}{1 - \omega^{2}L_{p}(C_{j} + C_{p}) + j\omega R_{p}C_{j}(1 - \omega^{2}L_{p}C_{p})}$$
(3.1)



그림 3.8. Varactor 다이오드의 등가회로. Fig 3.8. Equivalent circuit of varactor diode.

그림 3.9 (a)와 (b)는 제안된 낮은 대역 동작 반사 부하를 나타내며, λ/4 전송선로와 λ/4 개방 스터브는 협동 주파수에서 개방 특성을 나타낸다. λ /4 개방 스터브의 기생성분은 동작 주파수와 협동 주파수의 관계에 따라 달라지며, 이는 인덕터 또는 커패시터와 같은 보상 소자를 이용해 보상해 주었다.





그림 3.9. 동작 주파수에 따른 반사 부하의 구조: (a) 낮은 주파수 동작, (b) 높은 주파수 동작.

Fig 3.9. Structures of reflection load according to operating frequency: (a) low-frequency operating (b) high-frequency operating.

3.2.1. 낮은 주파수 동작

동작 주파수가 협동 주파수보다 낮은 경우, λ/4 개방 스터브는 동작 주 파수에서 커패시터처럼 동작한다. 이는 varactor 다이오드의 커패시턴스와 병렬 결합하어 커패시턴스의 감소를 불러일으키게 되고, 결과적으로 위상 변환 범위가 감소하게 된다. 따라서 동작 주파수에서 λ/4 개방 스터브의 기생 성분을 상쇄해 줄 수 있는 보상 소자가 연구되었다.

보상 소자는 스터브와 병렬연결되어 스터브의 어드미턴스와 같은 값, 반대의 부호를 가져야 스터브의 기생 성분을 보상해 줄 수 있다. 이에, 낮 은 주파수 동작에서는 그림 3.10과 같이 인덕터가 보상 소자로 사용되었 으며 식 (3.2)와 같이 수식적으로 나타낼 수 있다.





Fig 3.10. Compensation method at low-frequency operation.

$$L_c = \frac{1}{\omega_L Y_{Hs} \tan \theta_{Hs}}$$
(3.2)

반사 부하의 입력 어드미턴스(Y_{in,L})는 식 (3.3)과 같이 수식적으로 나타 낼 수 있다. 이때, X₁, X₂, X₃ 그리고 X₄는 식 (3.4-7)과 같이 주어지며 Y_{Hs}와 θ_{Hs}는 스터브의 어드미턴스와 전기각을, Y_{Ho}와 θ_{Ho}는 전송선로의 어드미턴스와 전기각을 의미한다.

$$Y_{in,L} = Y_{Ho} \frac{X_1 + jX_2}{X_3 + jX_4}$$
(3.3)

$$X_{1} = \left(1 - \omega^{2} L_{p} C_{p} - \omega^{2} L_{p} C_{j} - \omega^{2} L_{c} C_{p} - \omega^{2} L_{c} C_{j}\right) \cot \theta_{Hs} - \omega L_{c} \left(1 - \omega^{2} L_{p} C_{p} - \omega^{2} L_{p} C_{j}\right) (Y_{Hs} + Y_{Ho})$$
(3.4)

$$X_{2} = \cot \theta_{Hs} \left(\omega R_{p} C_{j} - \omega^{3} R_{p} L_{p} C_{p} C_{j} - \omega^{3} R_{p} L_{c} C_{p} C_{j} \right) - \omega L_{c} \left(Y_{Hs} + Y_{Ho} \right) \left(\omega R_{p} C_{j} - \omega^{3} R_{p} L_{p} C_{p} C_{j} \right)$$
(3.5)

$$X_{3} = \omega^{2} R_{p} L_{c} C_{j} \left(Y_{Ho} \cot \theta_{Hs} - Y_{Hs} \tan \theta_{Ho} \right) \left(-1 + \omega^{2} L_{p} C_{p} \right) - \omega R_{p} C_{j} \left(1 - \omega^{2} L_{p} C_{p} - \omega^{2} L_{c} C_{p} \right)$$
(3.6)

$$X_{4} = \begin{cases} 1 - \omega^{2} L_{p} C_{p} - \omega^{2} L_{p} C_{j} - \omega^{2} L_{c} C_{p} - \omega^{2} L_{c} C_{j} \\ + \left(Y_{Ho} \cot \theta_{Hs} - Y_{Hs} \tan \theta_{Ho}\right) \end{cases} \omega L_{c} \cot \theta_{Hs} \left(1 - \omega^{2} L_{p} C_{j} - \omega^{2} L_{p} C_{p}\right)$$
(3.7)

이를 통해 반사 부하의 반사 계수(*Γ_{in,L}*)의 크기와 위상(*Φ_{in,L}*)을 식 (3.8) 과 식 (3.9)와 같이 구할 수 있으며, 협동 주파수에서 반사 계수의 크기는 1임을 수식적으로 확인할 수 있다.

$$\left|\Gamma_{in,L}\right| = \frac{\left(Y_{Ho}X_{1} - Y_{0}X_{3}\right)^{2} + \left(Y_{Ho}X_{2} - Y_{0}X_{4}\right)^{2}}{\left(Y_{Ho}X_{1} + Y_{0}X_{3}\right)^{2} + \left(Y_{Ho}X_{2} + Y_{0}X_{4}\right)^{2}}$$
(3.8)
$$\phi_{in,L} = \tan^{-1}\left(\frac{Y_{Ho}X_{2} - Y_{0}X_{4}}{Y_{Ho}X_{1} - Y_{0}X_{3}}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{Y_{Ho}X_{2} + Y_{0}X_{4}}{Y_{Ho}X_{1} + Y_{0}X_{3}}\right)$$
(3.9)

3.2.2. 높은 주파수 동작

높은 주파수 동작의 경우, 동작 주파수에서 $\lambda/4$ 개방 스터브는 인덕터 처럼 동작한다. 기생 인덕턴스가 varactor 다이오드와 병렬 결합되면 더 낮은 커패시턴스를 포함할 수 있어 더 넓은 위상 변환 범위를 얻을 수 있 다.

하지만, 기생성분으로 발생하는 손실로 전체 위상 변환기의 삽입 및 반 사 손실에 영향을 주게 된다. 따라서 동작 주파수에서 λ/4 개방 스터브의 기생 성분을 보상해 주기 위해 그림 3.11과 같이 커패시터를 사용하였고, 식 (3.10)과 같이 수식적으로 나타낼 수 있다.





$$C_c = -\frac{Y_{Ls} \tan \theta_{Ls}}{\omega_{H}}$$
(3.10)

반사 부하의 입력 어드미턴스(Y_{in,H})는 식 (3.11)과 같이 수식적으로 나 타낼 수 있으며 X₅, X₆, X₇ 그리고 X₈는 식 (3.12-15)과 같이 주어진다. 이때, Y_{Ls}와 θ_{Ls}는 스터브의 어드미턴스와 전기각을 의미하고, Y_{Lo}와 θ_{Lo} 는 전송선로의 어드미턴스와 전기각을 의미한다.

$$Y_{in,H} = Y_{Lo} \frac{X_5 + jX_6}{X_7 + jX_8}$$
(3.11)

$$X_{5} = \omega R_{p} C_{j} \left\{ \left(Y_{Ls} + Y_{Lo}\right) \left(-1 + \omega^{2} L_{p} C_{p}\right) - \omega \left(C_{p} - \omega^{2} L_{p} C_{p} C_{c} - C_{c}\right) \right\} \cot \theta_{Ls}$$
(3.12)

$$X_{6} = \left(\omega C_{j} + \omega C_{p}\right)\cot\theta_{Ls} + \left(Y_{Ls} + Y_{Lo} + \omega C_{c}\cot\theta_{Ls}\right)\left(1 - \omega^{2}L_{p}C_{p} - \omega^{2}L_{p}C_{j}\right)$$
(3.13)

$$X_{7} = (Y_{Lo} \cot \theta_{Ls} - Y_{Ls} \tan \theta_{Lo} - \omega C_{c}) (1 - \omega^{2} L_{p} C_{p} - \omega^{2} L_{p} C_{j}) - (\omega C_{j} + \omega C_{p})$$
(3.14)

$$X_{8} = -\left(Y_{Lo}\cot\theta_{Ls} - Y_{Ls}\tan\theta_{Lo}\right)\left(\omega R_{p}C_{j}\right)\left(-1 + \omega^{2}L_{p}C_{p}\right) - \left(\omega^{2}R_{p}C_{j}\right)\left(C_{p} - \omega^{2}L_{p}C_{p}C_{c} + C_{c}\right)$$
(3.15)

이를 통해 반사 부하의 반사 계수(*Γ_{in,H}*)의 크기와 위상(*Φ_{in,H}*)을 식 (3.8) 과 식 (3.16)과 같이 구할 수 있으며, 협동 주파수에서 반사 계수의 크기 는 1임을 수식적으로 확인할 수 있다.

$$\left|\Gamma_{in,H}\right| = \frac{\left(Y_{Lo}X_{5} - Y_{0}X_{7}\right)^{2} + \left(Y_{Lo}X_{6} - Y_{0}X_{8}\right)^{2}}{\left(Y_{Lo}X_{5} + Y_{0}X_{7}\right)^{2} + \left(Y_{Lo}X_{6} + Y_{0}X_{8}\right)^{2}}$$
(3.16)

$$\phi_{in,H} = \tan^{-1} \left(\frac{Y_{Lo} X_6 - Y_0 X_8}{Y_{Lo} X_5 - Y_0 X_7} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{Y_{Lo} X_6 + Y_0 X_8}{Y_{Lo} X_5 + Y_0 X_7} \right)$$
(3.17)

3.3. 설계 순서도

그림 3.12는 제안된 반사 부하를 이용하여 원하는 성능을 얻을 수 있는 위상 변환기의 설계를 위한 알고리즘 순서도이다.



Fig 3.12. Algorithm flow chart for reflection load.

- 위 알고리즘 순서도의 진행은 다음과 같다.
 - 두 동작 주파수(f_L, f_H), 대역폭(BW) 그리고 주파수 대역의 number of point(NP)를 입력하고, 가변 변수인 전송선로와 스터브의 임피던스(Z_{Ls}, Z_{Lo}, Z_{Hs}, Z_{Ho})의 범위와 간격을 입력한다. 다른 입력 변수로 낮은 대역과 높은 대역에서 위상 변환 범위의 기준 값(Δφ_{ref_L}, Δφ_{ref_H}), 낮은 대역과 높은 대역에서 위상 편차의 기준 값(φ_{dev ref L}, φ_{dev ref H})과 반사 손실의 기준 값(mag_{ref})을 의미한다.
 - 가변 변수가 모두 1에서 정한 범위 내에 있을 때 동작 주파수에 따라 함수 DBPS_LB 또는 DBPS_HB를 통해 중심 주파수에서 위상 변환 범위(Δφ_L, Δφ_H), 대역 내 최대 위상 편차(φ_{dev_L}, φ_{dev_H}) 그리고 대역 내 최대 반사 손실(mag_L, mag_H)를 구할 수 있다.
 - 2.1. 두 동작 주파수와 대역폭 내에서 측정된 varactor 다이오드를 기반으로 시뮬레이션한 ADS의 다이오드 모델을 통해 얻은 파라미터의 값을 입력한다.
 - 2.2. f_L, f_H와 BW를 이용해 동작 주파수 대역 내 낮은 주파수(f_{L,L}, f_{H,L})와 높은 주파수(f_{L,H}, f_{H,H})를 정의하고 주파수를 의미하는 f 행렬을 만든다.
 - 2.3. 입력된 파라미터 Z_{Ls}, Z_{Lo}, Z_{Hs}, Z_{Ho} 등을 통해 위상 변환 범위(Δφ_{LB_L}, Δφ_{LB_H}, Δφ_{HB_L}, Δφ_{HB_H})를 계산한다.

2.4. 대역 내에서 최대 위상 변환 범위와 최소 위상 변환 범위의

차이를 반으로 나눈 값을 동작 주파수에 따라 $\phi_{dev_LB_L}$, $\phi_{dev_LB_H}$, $\phi_{dev_HB_L}$, $\phi_{dev_HB_H}$ 에, 대역 내 최대 반사 손실은 \max_{LB_L} , \max_{LB_H} , \max_{HB_L} , \max_{HB_H} 에 저장한다. V가 최솟값에서 최댓값까지 변화하는 동안 이를 반복한다.

- 함수 DBPS_LB 또는 DBPS_HB로부터 출력된 결과를 받아 함수 opt_LB 또는 opt_HB를 통해 주어진 조건에서 반사 부하로 얻을 수 있는 결과 중 기준값을 만족하는 파라미터를 찾는다.
 - 3.1. 동작 주파수 대역의 위상 변환 범위가 Δφ_{ref}보다 크고, 동작 및 협동 주파수 대역에서의 최대 위상 편차가 φ_{dev_ref}보다 작고 최대 반사 손실이 mag_{ref}보다 작은 조건을 만족할 수 있는 Z_{Ls}, Z_{Lo}, Z_{Hs}, Z_{Ho}를 찾는다.
 - 3.2. 위 조건을 모두 만족하는 파라미터를 Z_{Ls_opt},, Z_{Lo_opt},, Z_{Hs_opt},, Z_{Ho_opt}에 저장하고, 해당 파라미터를 통해 계산된 위상 변환 범위는 Δφ_{LB_L_opt}, Δφ_{LB_H_opt}, Δφ_{HB_L_opt}, Δφ_{HB_H_opt}에, 위상 편차는 φ_{dev_LB_L_opt}, φ_{dev_LB_H_opt}, φ_{dev_HB_L_opt}, φ_{dev_HB_H_opt}에, 반사 손실은 mag_{LB_L_opt}, mag_{LB_H_opt}, mag_{HB_L_opt}, mag_{HB_H_opt}에 저장한다.
- 함수 opt_LB 또는 opt_HB로부터 저장된 결과를 받아 대역 내 위상 편차가 가장 작은 값을 갖는 결과를 도출한다.

4. 이중 대역 위상 변환기의 설계 및 측정

4.1. 반사 부하의 설계

동작 주파수는 1.88 GHz와 2.44 GHz이며 100 MHz의 대역폭을 갖고 협동 주파수에 영향을 주지 않고 독립적으로 동작하는 이중 대역 위상 변 환기의 설계를 위해, 동일한 동작 주파수와 대역폭에서 동작하는 반사 부 하를 설계했다. 동작 주파수에서 위상 변환 범위는 varactor 다이오드 하 나로만 구성된 반사 부하의 위상 변환 범위와 동일하게 105°와 121°로 정 했다. 앞선 3.1절에서와 같이 varactor 다이오드 SMV-1231의 측정값을 통해 ADS 다이오드 등가회로 모델을 구현하였다. 가변 커패시턴스는 다 이오드 등가회로 모델을 통해 얻은 파라미터 값을 사용하였다. 원하는 성 능을 얻을 수 있도록 제안한 반사 부하의 파라미터를 구하기 위해 3.3절 에서 다룬 순서도를 통해 MATLAB을 진행하였다.

4.1.1. 낮은 주파수 동작

3.2.1절에서 언급했던 것과 같이 $\lambda/4$ 개방 스터브는 동작 주파수에서 커 패시턴스 성분을 갖고, 협동 주파수에서 단락 특성을 나타내는 것을 그림 4.1에서 확인할 수 있다. 이는 그림 4.2에서 나타낸 것과 같이 varactor 다 이오드만 연결되어 있었을 때의 위상 변환 범위인 105°보다 65° 더 감소 된 40°의 위상 변환 범위를 갖는다. 따라서, 제안한 반사 부하는 $\lambda/4$ 개방 스터브의 기생 성분을 상쇄시켜줄 수 있는 보상 소자를 사용하였다.

제안한 낮은 동작 반사 부하의 파라미터 계산 결과는 표 4.1에 나타냈 으며, 그림 4.3은 설계 파라미터 Z_{Hs}, Z_{Ho}, θ_{Hs} , θ_{Ho} 의 값을 이용한 반사 부하 회로와 이상적인 ADS 시뮬레이션 결과이다. 보상 소자를 사용하여 사용하지 않았을 경우보다 넓은 위상 변환 범위를 얻을 수 있다.



그림 4.1. 낮은 대역 동작에서 $\lambda/4$ 개방 스터브의 스미스 차트. Fig 4.1. Smith chart of $\lambda/4$ open stub at low-band operation.



그림 4.2. 보상소자가 없을 때 낮은 대역 동작 ADS 시뮬레이션: (a) 위상 특성, (b) 반사 손실 특성.

Fig 4.2. Low-band operation ADS simulation without compensation element: (a) phase characteristic, (b) return loss characteristic.

표 4.1. 낮은 대역 동작 반사 부하의 파라미터 계산 결과.

Table 4.1. Results of parameter calculation of reflection load in low-band operation.

$Z_{Ho} [\Omega] = \epsilon$		Θ_{I}	40 [°]	Z_{E}	_{Is} [Ω]	Θ_{Hs}	, [°]	Lc [nH]
49			90		120	(90	3.8297
$\Delta \phi_L$ [°]	$\phi_{dev_{-}}$	[°]	RL _{LB_L}	[dB]	$\Delta \phi_H$ [°]	Ф _{der}	[°]	RL _{LB_H} [dB]
105.666	± 9.	.9938	0.845	50	0.000	± 1	1.4552	0.1349











그림 4.3. 낮은 대역 동작 ADS 시뮬레이션: (a) 회로, (b) 위상 특성, (c) 반사 손실 특성.

Fig 4.3. Low-band operation ADS simulation: (a) circuit diagram, (b) phase characteristic, (c) return loss characteristic.

4.1.2. 높은 주파수 동작

3.2.2절에서 언급했던 것과 같이 $\lambda/4$ 개방 스터브는 그림 4.4와 같이 동 작 주파수에서 인덕터 성분을, 협동 주파수에서 단락 특성을 나타낸다. 그 림 4.5에서 나타낸 것과 같이 보상 소자를 사용하지 않았을 경우가 보상 소자를 사용하였을 때 보다 81° 넓은 위상 변환 범위 특성을 보이지만 전 체 회로의 삽입 손실에 영향을 주는 반사 부하의 반사 손실이 최대 1.541 dB의 특성을 보여 이 손실을 줄이기 위해 보상 소자를 사용하였다.

제안한 높은 대역에서 동작하는 반사 부하의 파라미터 계산 결과는 표 4.2에 나타내었으며, 그림 4.6은 설계 파라미터 Z_{Ls}, Z_{Lo}, θ_{Ls} , θ_{Lo} 의 값을 이용한 반사 부하 회로와 이상적인 ADS 시뮬레이션 결과이다.



그림 4.4. 높은 대역 동작에서 $\lambda/4$ 개방 스터브의 스미스 차트. Fig 4.4. Smith chart of $\lambda/4$ open stub at high-band operation.



그림 4.5. 보상소자가 없을 때 높은 대역 동작 ADS 시뮬레이션: (a) 위상 특성, (b) 반사 손실 특성.

Fig 4.5. High-band operation ADS simulation without compensation element: (a) phase characteristic, (b) return loss characteristic.

표 4.2. 높은 대역 동작 반사 부하의 파라미터 계산 결과.

Table 4.2. Results of parameter calculation of reflection load in high-band operation.

$Z_{Lo} [\Omega] \qquad \Theta_{Lo}$		[°]	Z_{Ls}	[Ω]		Θ_{Ls} [°]	<i>Cc</i> [pF]	
50		Q	90	1	18 90		90	1.0757
$\Delta \phi_L$ [°]	ϕ_{dev}	,_ <i>L</i> [°]	RL _{HB_I}	[dB]	$\Delta \phi_H$ [°]	ϕ_{dev_H} [°]	RL_{HB_H} [dB]
0.000	±]	.6165	0.08	309	121.823	32	± 9.4777	0.9286



(a)



Eqn PSR_HB=unwrap(phase(S(2,2)))[::,::]-unwrap(phase(S(2,2)))[0,::]

(b)



그림 4.6. 높은 대역 동작 ADS 시뮬레이션: (a) 회로, (b) 위상 특성, (c) 반사 손실 특성.

Fig 4.6. High-band operation ADS simulation: (a) circuit diagram, (b) phase characteristic, (c) return loss characteristic.

4.2. 위상 변환기의 시뮬레이션 및 측정 결과

제안된 반사 부하를 이용한 이중 대역 위상 변환기를 설계하였으며, 시 뮬레이션과 제작 및 측정을 통해 특성을 검증하였다. 설계에 사용된 기판 은 Rogers 사의 RT/Duroid 5880으로 *ε_r* = 2.2, tanD = 0.0009 그리고 h = 0.787 mm이며, 3-dB 하이브리드 결합기는 Anaren 사의 S03A2500N1 을 사용했다. 그림 4.7은 4.1.1절과 4.1.2절에서 설계된 낮은 주파수와 높은 주파수에서 동작하는 반사 부하를 적용한 위상 변환기의 회로이다. 반사 부하에 적용된 마이크로스트립 선로는 실제 구현이 가능한 규격으로 최적 화를 했으며, 그 치수와 소자들의 값을 표 4.3에 나타내었다.



그림 4.7. 제안한 위상 변환기의 회로. Fig 4.7. Circuit diagram of proposed phase shifter.

표 4.3. 제안한 위상 변환기의 물리적 치수와 소자 값.

W _{Ho} [mm]	L _{Ho} [mm]	W _{Hs} [[mm]	L _{Hs} [mm]	Lc [nH]
2.4	22.4	0.	5	23	3.5
W_{Lo} [mm]	L_{Lo} [mm]	W_{Ls} [mm] L _{Ls} [mm]		<i>Cc</i> [pF]
2.4	29	0.	5	30	0.92
	L_c [nH]			$C_c [pF]$]
	3.82		1		

Table 4.3. Physical dimensions and component values of proposed phase shifter

그림 4.8은 제작된 위상 변환기의 사진이며, 제안된 위상 변환기의 시뮬 레이션 및 측정 결과를 동작 주파수에 따라 그림 4.9-11에 나타내었다. 그림 4.9는 낮은 주파수 동작, 그림 4.10은 높은 주파수 동작 그리고 그림 4.11은 이중 대역 동작의 결과를 의미한다. 그림 4.9-11에서 (a)는 위상이 30°의 간격으로 변하는 동안의 위상 특성을 주파수 축으로 나타낸 것이 고, (b)는 동일한 조건 내의 삽입 손실 특성을, (c)는 동일한 조건 내의 반사 손실 특성을 나타내었다. 또한, 동작 주파수에 따른 시뮬레이션 및 측정 결과는 표 4.4-6에 나타내었다. PSR(Phase Shifting Range)은 위상 변환 범위, PD(Phase Deviation)는 위상 편차, IL(Insertion loss)은 삽입 손실, 그리고 RL(Return loss)은 반사 손실을 의미한다.



그림 4.8. 제작된 위상 변환기의 사진. Fig 4.8. Photograph of fabricated phase shifter.



(a)



(b)



(c)

그림 4.9. 낮은 대역 동작의 시뮬레이션 및 측정 결과: (a) 위상 특성, (b) 삽입 손실 특성, (c) 반사 손실 특성.

Fig 4.9. Simulation and measurement result at low-band operation: (a) phase characteristic, (b) insertion loss characteristic, (c) return loss characteristic.

표 4.4. 낮은 대역 동작 시 시뮬레이션 및 측정 결과.

Table 4.4. Simulation and measurement results at low-band operation.

		Sim.	Mea.
	Max. PSR [°]	105.203	114.194
@f	Max. in-band PD [°]	± 1.8495	± 8.2615
	IL [dB]	< 1.096	< 1.867
	RL [dB]	> 22.887	> 19.674
	Max. PSR [°]	0.179	0.225
@ f	Max. in-band PD [°]	± 1.0495	± 0.936
@ <i>J_H</i>	IL [dB]	< 1.062	< 1.897
	RL [dB]	> 27.253	> 16.684



(b)



(c)

그림 4.10. 높은 대역 동작의 시뮬레이션 및 측정 결과: (a) 위상 특성, (b) 삽입 손실 특성, (c) 반사 손실 특성.

Fig 4.10. Simulation and measurement result at high-band operation:(a) phase characteristic, (b) insertion loss characteristic, (c) return loss characteristic.

표 4.5. 높은 대역 동작 시 시뮬레이션 및 측정 결과.

Table 4.5. Simulation and measurement results at high-band operation.

		Sim.	Mea.
	Max. PSR [°]	0.008	0.360
@ f_L	Max. in-band PD [°]	± 1.099	± 1.035
	IL [dB]	< 1.96	< 1.867
	RL [dB]	> 22.854	> 22.550
	Max. PSR [°]	121.336	114.097
@ f	Max. in-band PD [°]	± 7.809	± 6.076
@ <i>J_H</i>	IL [dB]	< 1.062	< 1.983
	RL [dB]	> 16.689	> 16.833







그림 4.11. 이중 대역 동작의 시뮬레이션 및 측정 결과: (a) 위상 특성, (b) 삽입 손실 특성, (c) 반사 손실 특성.

Fig 4.11. Simulation and measurement result at both-band operation:(a) phase characteristic, (b) insertion loss characteristic, (c) return loss characteristic.

표 4.6. 이중 대역 동작 시 시뮬레이션 및 측정 결과.

Table 4.6. Simulation and measurement results at both-band operation.

		Sim.	Mea.
	Max. PSR [°]	105.203	114.134
@ f	Max. in-band PD [°]	± 1.86	± 8.43
$@ J_L$	IL [dB]	< 1.096	< 1.867
	RL [dB]	> 22.887	> 19.695
	Max. PSR [°]	121.414	114.017
@ f	Max. in-band PD [°]	± 7.89	± 5.409
@ <i>J_H</i>	IL [dB]	< 1.062	< 1.897
	RL [dB]	> 16.273	> 16.833

5. 고찰 및 선행 연구 결과 비교

앞 4.2절의 표 4.5-7에서 볼 수 있듯이 제안한 위상 변환기의 측정 결과 는 시뮬레이션과 차이를 보인다. 위상 변환 범위는 보상 소자로 사용한 인덕터와 커패시터가 동작 주파수에서 λ/4 개방 스터브의 기생성분을 완 벽하게 보상해 주지 못하여 약간의 오차가 발생하였다. 또한, 위상 편차와 삽입 및 반사 손실에서 발생한 오차는 시뮬레이션 된 다이오드 등가 모델 과 실제 사용되는 varactor 다이오드의 대역 내 커패시턴스의 변화가 갖 는 오차와 실제 구현된 전송선로에서 발생하는 손실에서 발생한다. ADS 의 다이오드 모델은 두 동작 주파수의 중심 주파수를 기준으로 만들어지 며, 두 동작 주파수에서 실제 varactor 다이오드와 동일한 특성 구현에 어 려움으로 인해 오차가 발생할 수 있다.

표 5.1은 선행 연구되었던 반사형 구조의 위상 변환기와 제안된 위상 변환기의 성능 비교이다. 기존 연구되었던 위상 변환기는 단일 대역에서 만 동작한다는 한계를 갖고 있으며, 대역 내 위상 편차에 큰 비중을 두지 않고 있다. 참고문헌 [14]와 [15]와 같이 이중 대역에서 동작하는 위상 변 환기는 최근 많이 연구되고 있지만, CMOS 또는 화합물 공정을 이용하여 제작한다는 어려움이 있다.

제안하는 위상 변환기는 이중 대역에서 독립적으로 동작한다는 장점이 있다. 또한, 두 대역에서 모두 100°이상의 넓은 위상 변환 범위를 가지며 15 dB 이상의 반사 손실 특성으로 기존 이중 대역 위상 변환기보다 반사 손실 특성이 뛰어난 것을 알 수 있다.

ref.	freq.	BW	PSR	PD	IL	RL	Dual-
	[GHz]	[MHz]	[°]	[°]	[dB]	[dB]	Band
[9]	2	200	407	_	< 4.6	> 14	Х
[10]	2	200	201	_	< 0.63	> 22	Х
	2	200	385	_	< 1.56	> 13.4	Х
[11]	10	1000	190	± 10	< 2.3	> 10	Х
[12]	1.5	1000	350	± 100	< 5.8	> 14	Х
[13]	2.5	500	146.9	± 5.79	< 1.28	> 15.76	Х
[14]	3.5	20	360	± 3	< 3.7	> 10	0
	5.8	20	360	±3	< 4.5	> 10	
[15]	5.9	200	106	± 7	< 2.8	> 10	0
	16	400	105	± 2	< 3.5	> 10	
This	1.88	100	114.134	± 8.43	< 1.867	> 19.674	0
work	2.44	100	114.017	± 6.076	< 1.983	> 16.684	U

표 5.1. 선행 연구 결과와 제안된 위상 변환기의 성능 비교. Table 5.1. Performance of the proposed design against state-or art

alternatives.

6. 결론

본 논문에서는 $\lambda/4$ 개방 스터브로 구성된 반사 부하로 구성된 위상 변 환기를 제안하고 있으며 반사형 구조를 통해 뛰어난 반사 손실 특성을 갖 는 이중 대역 위상 변환기를 설계하였다. 위상 변환기의 가변 특성은 varactor 다이오드를 이용하여 인가전압에 따라 달라지는 커패시턴스 값 을 통해 연속적인 위상 변환 특성을 성취하였다. 반사 부하에 포함된 전 송선로와 개방 스터브는 협동 주파수에서 $\lambda/4$ 의 전기각 특성으로 협동 주 파수에서 개방 특성을 나타낸다. 이는 협동 주파수에 영향을 주지 않고 서로 독립적인 동작을 가능하게 한다.

하지만, $\lambda/4$ 개방 스터브는 동작 주파수에서 리액턴스 성분을 갖고 있 어 위상 변환 범위에 영향을 준다. 이를 해결하기 위해 동작 주파수와 협 동 주파수의 관계에 따라 달라지는 스터브의 리액턴스 성분을 정의하고, 해당 리액턴스 성분을 상쇄해 줄 수 있는 보상 소자를 선택하였다.

또한, varactor 다이오드의 등가회로를 적용하여 다이오드의 기생 성분 을 고려하였고, 반사 부하의 반사계수 및 위상 식을 유도하였다. 각 파라 미터를 적절하게 조절하여 대역 내에서 낮은 위상 편차를 가지면서 varactor 다이오드만을 사용하였을 때와 동일한 위상 변환 범위를 얻을 수 있는 순서도를 제시하였다.

설계의 검증을 위해 1.88 GHz와 2.44 GHz의 두 동작 주파수에서 동작 하는 이중 대역 위상 변환기를 제작 및 측정했다. 측정 결과로부터, 설계 된 이중 대역 위상 변환기는 동작 주파수에서 위상 변환 범위가 각각 114.134°, 114.017°이며, 100 MHz의 대역 내에서 위상 편차는 각각 ±8.43°, ±6.076°로 적은 위상 편차 특성을 보인다. 또한, 두 대역 내에서 1.867 dB, 1.983 dB 이내의 삽입 손실과 19.674 dB, 16.684 dB 이상의 반사 손실을 얻었다.

제안된 마이크로파 이중 대역 위상 변환기는 대역 내 적은 위상 편차와 높은 반사 손실 특성이 있어 차세대 무선 통신 시스템에서 널리 이용될 수 있다. 또한, 기존 연구되었던 이중 대역 위상 변환기보다 제작이 편리 하고, 하나의 어플리케이션으로 이중 대역의 신호를 처리할 수 있어 제품 의 소형화에도 이점이 있다.

참고문헌

- J. R. De Luis and F. De Flaviis, "A reconfigurable dual frequency switched beam antenna array and phase shifter using PIN diodes," 2009 IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium, pp. 1 - 4, Jun. 2009.
- [2] W. Wenwei, C. Chunhong, W. Shiyan, and W. Wen, "Switchable Dual-band Dual-sense Circularly Polarized Patch Antenna Implemented by Dual-band Phase Shifter of ±90°," *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, vol. 69, no. 10, pp. 6912–6917, Oct. 2021.
- [3] X. Yang, and J. Lin, "A digitally controlled constant envelop phase-shift modulator for low-power broadband wireless applications," *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, vol. 54, no. 1, pp. 96 - 105, Jan. 2006.
- [4] E. A. Sobhy, and S. Hoyos, "A Multiphase Multipath Technique With Digital Phase Shifters for Harmonic Distortion Cancellation," *IEEE Transactions on Circuits Systems-II: Express Briefs*, vol. 57, no. 12, pp. 921 - 925, Dec. 2010.
- [5] V. Szortyka, K. Raczkowski, M. Kuijk, and P. Wambacq, "A wideband beamforming lowpass filter for 60 GHz phased-array receivers," *IEEE Transactions on Circuits Systems- I: Regular Papers*, vol. 62, no. 9, pp. 2324 - 2333, Sep. 2015.
- [6] P. Anand, S. Sharma, D. Sood, and C. C. Tripathi, "Design of compact reconfigurable switched line microstrip phase shifters for phased array antenna," *Emerging Technology Trends in Electronics, Communication and Networking Conference*, pp.1–3, Dec.2012.
- [7] W. H. Woods, A. Valdes-Garcia, H. Ding, and J. Rascoe, "CMOS millimeter wave phase shifter based on tunable transmission lines,"

Proceeding of the IEEE 2013 Custom Integrated Circuits Conference, pp. 1–4, Sep. 2013.

- [8] H. Kim, A. B. Kozyrev, A. Karbassi, and D. W. van der Weide, "Linear Tunable Phase Shifter Using a Left-Handed Transmission Line," *IEEE Microwave and Wireless Components Letters*, vol. 15, no. 5, pp. 366 – 368, May. 2005.
- [9] C. S. Lin, S. F. Chang, and W. C. Hsiao, "A full 360° RTPS with constant insertion loss," *IEEE Microwave and Wireless Components Letters*, vol. 18, no. 2, pp. 106 - 108, Feb. 2008.
- [10] F. Burdin, Z. Iskandar, F. Podevin, and P. Ferrari, "Design of compact reflection-type phase shifters with high figure-of-merit," *IEEE Transactions on Microwave Theory and techniques*, vol. 63, no. 6, pp. 1883 - 1893, Jun. 2015.
- [11] A. Singh, and M. K. Mandal, "Electronically Tunable Reflection Type Phase Shifters," *IEEE Transactions on circuits and* systems-II: Express Briefs, vol. 67, no. 3, pp. 425–429, Mar. 2020.
- [12] A. M. Abbosh, "Compact tunable reflection phase shifters using short section of coupled lines," *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, vol. 60, no. 8, pp. 2465 - 2472, Aug. 2012.
- [13] B. An, G. Chaudhary, and Y. Jeong, "Wideband tunable phase shifter with low in-band phase deviation using coupled line," *IEEE Microwave Wireless Components Letters*, vol. 28, no. 8, pp. 678 - 680, Aug. 2018.
- [14] C. Lu, A.-V. H. Pham, and D. Livezey, "Development of multiband phase shifters in 180-nm RF CMOS technology with active loss compensation," *IEEE Transactions on microwave theory and techniques*, vol. 54, no. 1, pp. 40 - 45, Jan. 2006.
- [15] Y. Xiong, X. Zeng, and J. Li, "A tunable concurrent dualband phase shifter MMIC for beam steering applications," *IEEE Transactions on Circuits and Systems-II: Express Briefs*, vol. 67,

no. 11, pp. 2412-2416, Nov. 2020.

Appendix : MATLAB code

- Low-band operation

Input value

f_L	f_H	BW	NP
1.88E+9	2.44E+9	100E+6	201
Z_Ho	Z_Hs		
20:1:70	100:1:120		
PSR_ref_L	PD_ref_L	PD_ref_H	mag_ref
100	10	10	-1

Main code

%% display value [PSR LB L opt, PSR LB H opt, PD LB L opt, PD LB H opt, mag LB L _opt,mag_LB_H_opt,Z_Ho_opt,Z_Hs_opt]=opt_LB(Z0,Z_Ho,Z_Hs,FH ,fL,BW,PD ref L,PD ref H,mag ref); a=1:length(Z Ho); b=1:length(Z_Hs); PD LB L=max(PD LB L opt(a,b),[],'all'); [a o, b o]=find(PD LB L opt(a, b)==PD LB L); Z Ho(a_o); Z Hs(b_o); disp('lowband PSR PD mag') A =[PSR_LB_L_opt(a_o,b_o),PD_LB_L_opt(a_o,b_o),mag_LB_L_opt(a_ o, b 0)]; disp(A) disp('highband PSR PD mag') B = [PSR LB H opt(a o,b o), PD LB H opt(a o,b o), mag LB H opt(a o, b 0)]; disp(B) disp('Impedance of TL stub') $C = [Z Ho opt(a_o, b_o), Z Hs_opt(a_o, b_o)];$ $disp(\overline{C})$

Function code

```
function
[PSR LB L opt, PSR LB H opt, PD LB L opt, PD LB H opt, mag LB L
 opt, mag LB H opt, Z Ho opt, Z Hs opt] = opt LB (ZO, Z Ho, Z Hs, fH
,fL,BW,PD ref L,PD ref H,mag ref)
[Z \text{ Ho } m, Z \text{ Hs } \overline{m}] = nd\overline{q}rid(Z \text{ Ho}, \overline{Z} \text{ Hs});
PSR LB L=zeros(length(Z Ho), length(Z Hs));
PSR LB H=zeros(length(Z Ho), length(Z Hs));
PD \overline{LB} \overline{L}=zeros(length(Z \overline{Ho}), length(Z \overline{Hs}));
PD_LB_H=zeros(length(Z_Ho),length(Z_Hs));
mag LB L=zeros (length (\overline{Z} Ho), length (\overline{Z} Hs));
mag_LB_H=zeros(length(Z_Ho), length(Z_Hs));
PSR LB L opt=zeros(length(Z Ho), length(Z Hs));
PSR LB H opt=zeros(length(Z Ho), length(Z Hs));
PD IB I opt=zeros(length(Z Ho), length(Z Hs));
PD_LB_H_opt=zeros(length(Z_Ho),length(Z_Hs));
mag_LB_L_opt=zeros(length(Z_Ho),length(Z_Hs));
mag_LB_H_opt=zeros(length(Z_Ho), length(Z_Hs));
for a=1:length(Z Ho)
    for b=1:length(Z Hs)
[PSR LB L(a,b), PSR LB H(a,b), PD LB L(a,b), PD LB H(a,b), mag
LB L(a, \overline{b}), mag LB H(a, \overline{b}) = DBPS L\overline{B}(Z\overline{0}, Z Ho m(\overline{a, b}), \overline{Z} Hs m(\overline{a, b})
,fH,fL,BW);
         if PD LB L(a,b) <= PD ref L
              if PD LB H(a,b) <= PD ref H
                  if mag LB L(a,b)>mag ref
                       if mag LB H(a,b) > mag ref
                           PSR LB H opt(a,b)=PSR LB H(a,b);
                           PSR LB L opt (a, b) = PSR LB L (a, b);
                           PD \overline{LB} \ \overline{L} \ \overline{opt}(a,b) = PD \ L\overline{B} \ L(a,b);
                           PD_LB_H_opt(a,b) = PD_LB_H(a,b);
                           mag_LB_L opt(a,b) =mag_LB_L(a,b);
mag_LB_H_opt(a,b) =mag_LB_H(a,b);
                           Z Ho opt(a, b) = Z Ho(a);
Z Hs opt(a,b) = Z Hs(b);
                       end
                  end
             end
         end
    end
end
end
```

Function code

```
function
[PSR LB L, PSR LB H, PD LB L, PD LB H, mag LB L, mag LB H]=DBPS
LB(ZO,ZHO,Z HS, TH, fL, BW);
V=17; C<sup>p</sup>=0.12E-12; L p=0.7689E-9; R p=3;
C j=linspace(2.435E-12,0.18E-12,V);
f=linspace(1E9,3E9,NP); w=2*pi.*f; NP=201;
F L L=(find(abs(f*1e-9-(fL-BW/2)*1e-9)<=1e-10));
F^{-}L^{-} (find (abs (f*1e-9-fL*1e-9) <=1e-10));
F<sup>L</sup> H=(find(abs(f*1e-9-(fL+BW/2)*1e-9)<=1e-10));
F<sup>H</sup>L=(find(abs(f*1e-9-(fH-BW/2)*1e-9)<=1e-10));
F H=(find(abs(f*1e-9-fH*1e-9)<=1e-10));</pre>
FH H=(find(abs(f*1e-9-(fH+BW/2)*1e-9)<=1e-10));
Y\overline{0}=\overline{1}./Z0; Y Ho=1./Z Ho; Y Hs=1./Z Hs;
L com=1./(2.*pi.*fL.*Y Hs.*tan(pi72.*fL./fH));
L_com=1./(2.^pi.^iL.~i_ns.com(pi/2. iL.,in,,),
theta_Ho=(pi/2.*f./fH); theta_Hs=(pi/2.*f./fH);
X5=(1-w.^2.*L_p.*C_p-w.^2.*L_p.*C_j'-w.^2.*L_com.*C_p-w.^2.
*L_com.*C_j').*cot(theta_Hs)-(1-w.^2.*L_p.*C_p-w.^2.*L_p.*C_j').*(w.*L_com).*(Y_Hs+Y_Ho);
X6=(w.*R_p.*C_j'-w.^3*R_p.*L_p.*C_p.*C_j'-w.^3*R_p.*L_com.*
C_n + C_j').*cot(theta_Hs)-(w_*T_com).*(Y_Hs+Y_Ho).*(w.*R_p.
C p.*C j).*cot(theta Hs)-(w.*L com).*(Y Hs+Y Ho).*(w.*R p.
*Ĉ
   _j'-w.^3*R_p.*L_p.*C_p.*C_j');
X7=(w.^2.*R p.*L com.*C j').*(Y Ho.*cot(theta Hs)-Y Hs.*tan
(theta_Ho)).*(-1+w.^2.*L p.*C p)-(w.*R p.*C j').*(1-w.^2.*L
 p.*C \overline{p}-w.^2.*L com.*C \overline{p};
X8=(1-w.^2.*L p.*C p-w.^2.*L p.*C j'-w.^2.*L com.*C p-w.^2.
*L com.*C j')+(Y Ho.*cot(theta Hs)-Y Hs.*tan(theta_Ho)).*(w
.*L com).*(1-w.^2.*L p.*C j'-w.^2.*L_p.*C_p);
Yin_LB=Y Ho*(X5+j*X6)./(X7+j*X8);
S11Y LB=(Y0-Yin LB)./(Y0+Yin LB);
mag \overline{L}B c=20*log\overline{1}0 (abs(S11Y L\overline{B}));
phase LB=rad2deg(unwrap(angle(S11Y LB)));
if phase LB(1,NP) > phase LB(V,NP)
     PSR LB c=phase LB(:,:) - (ones (V,1) *phase LB(V,:));
else
     PSR LB c=phase LB(:,:)-(ones(V,1)*phase LB(1,:));
end
PSR LB=PSR LB c;
PSR LB L=max(abs(PSR LB c(:,F L)));
PSR LB H=max(abs(PSR LB c(:, F H)));
for i=1:V
    mag LB L c(i)=min(mag LB c(i,F L L:F L H));
    mag LB H c(i)=min(mag LB c(i, F H L:F H H));
end
mag LB L=min(mag LB L c(1:V));
mag_LB_H=min(mag_LB_H_c(1:V));
for i=1:V
PD LB L c(i) = (max(PSR LB c(i, F L L: F L H)) - min(PSR LB c(i, F
 L<sup>-</sup>L:F <u>L</u> H)))/2;
PD_LB_H_c(i) = (max(PSR_LB_c(i,F H L:F H H)) -min(PSR LB c(i,F
 H_L:F H H)))/2;
end
PD LB L=max(PD LB L c(1:V));
PD_LB_H=max(PD_LB_H_c(1:V));
en\overline{d}
```

- High-band operation

Input value

f_L	f_H	BW	NP
1.88E+9	2.44E+9	100E+6	201
Z_Lo	Z_Ls		
20:1:20	20:1:200		
PSR_ref	PD_ref_L	PD_ref_H	mag_ref
100	10	10	-1

Main code

%% display value [PSR_HB_L_opt,PSR_HB_H opt,PD HB L opt,PD HB H opt,mag HB L _opt,mag_HB_H_opt,Z_Lo_opt,Z_Ls_opt]=opt HB(Z0,Z_Lo,Z_Ls,FH ,fL,BW,PD ref L,PD ref H,mag ref); a=1:length(Z_Lo); b=1:length(Z_Ls); PD_HB_H=max(PD_HB_H_opt(a,b),[],'all'); [a_o,b_o]=find(PD_HB_H_opt(a,b)==PD_HB_H); Z_Lo(a_o); Z_Ls(b_o); disp('lowband_PSR_PD_mathered) mag') A =[PSR_HB_L_opt(a_o,b_o),PD_HB_L_opt(a_o,b_o),mag_HB_L_opt(a_ o, b 0)]; disp(A) disp('highband PSR PD mag') в = [PSR HB H opt(a o,b o),PD HB H opt(a o,b o),mag HB H opt(a o,b 0)]; disp(B) disp('Impedance of TL stub')
C = [Z_Lo_opt(a_o,b_o),Z_Ls_opt(a_o,b_o)]; disp(C)

```
Function code
```

```
%% high-band PSR
function
[PSR HB L opt, PSR HB H opt, PD HB L opt, PD HB H opt, mag HB L
opt, mag HB H opt, Z Lo opt, Z Ls opt]=opt HB(Z0, Z Lo, Z Ls, FH
,fL,BW,PD ref L,PD ref H,mag ref)
[Z \text{ Lo } m, Z \text{ Ls } m] = ndqrid(Z \text{ Lo}, \overline{Z} \text{ Ls});
PSR HB L=zeros(length(Z Lo), length(Z Ls));
PSR HB H=zeros (length (Z Lo), length (Z Ls));
PD_HB_L=zeros(length(Z_Lo),length(Z_Ls));
PD_HB_H=zeros(length(Z_Lo),length(Z_Ls));
mag_HB_L=zeros(length(Z_Lo),length(Z_Ls));
mag HB H=zeros(length(Z Lo), length(Z Ls));
PSR HB L opt=zeros(length(Z Lo),length(Z Ls));
PSR HB H opt=zeros(length(Z Lo), length(Z Ls));
PD HB L opt=zeros(length(Z Lo),length(Z Ls));
PD HB H opt=zeros(length(Z Lo), length(Z Ls));
mag HB \overline{L} opt=zeros(length(\overline{Z} Lo), length(\overline{Z} Ls));
mag HB H opt=zeros(length(Z Lo), length(Z Ls));
for a=1:length(Z Lo)
     for b=1:length(Z Ls)
[PSR HB L(a,b), PSR HB H(a,b), PD HB L(a,b), PD HB H(a,b), mag
HB L(a, \overline{b}), mag HB H(\overline{a}, \overline{b})]=DBPS HB(Z\overline{0}, Z Lo m(\overline{a, b}), \overline{Z} Ls m(\overline{a, b})
,fH,fL,BW);
         if PD_HB_L(a,b)<=PD_ref_L
    if PD_HB_H(a,b)<=PD_ref_H</pre>
                   if mag_HB_L(a,b)>mag_ref
    if mag_HB_H(a,b)>mag_ref
                            PSR HB H opt(a,b)=PSR HB H(a,b);
                            PSR HB L opt(a, b) = PSR HB L(a, b);
                            PD \overline{HB} \ \overline{L} \ \overline{opt}(a,b) = PD \ H\overline{B} \ \overline{L}(a,b);
                            PD HB H opt(a, b) = PD HB H(a, b);
                            mag H\overline{B} \overline{L} opt(a,b)=mag \overline{H}B L(a,b);
                            mag HB H opt(a, b) = mag HB H(a, b);
                            Z Lo opt(a,b) = Z Lo(a);
Z Ls opt(a,b) = Z Ls(b);
                       end
                   end
              end
         end
    end
end
end
```

```
Function code
```

```
function
[PSR HB L, PSR HB H, PD HB L, PD HB H, mag HB L, mag HB H]=DBPS
HB(ZO,Z LO,Z LS, TH, fL, BW);
V=17; C<sup>p</sup>=0.12E-12; L p=0.7689E-9; R p=3;
C j=linspace(2.435E-12,0.18E-12,V);
f=linspace(1E9,3E9,NP); w=2*pi.*f; NP=201;
F L L=(find(abs(f*1e-9-(fL-BW/2)*1e-9)<=1e-10));
F<sup>L</sup>=(find(abs(f*1e-9-fL*1e-9)<=1e-10));</pre>
F<sup>L</sup> H=(find(abs(f*1e-9-(fL+BW/2)*1e-9)<=1e-10));</pre>
F<sup>H</sup>L=(find(abs(f*1e-9-(fH-BW/2)*1e-9)<=1e-10));
F = (find(abs(f*1e-9-fH*1e-9) <=1e-10));
F<sup>H</sup> H=(find(abs(f*1e-9-(fH+BW/2)*1e-9)<=1e-10));
Y\overline{0}=\overline{1}./Z0; Y Lo=1./Z Lo; Y Ls=1./Z Ls;
theta Lo=(pi/2.*f./fL); theta Ls=(pi/2.*f./fL);
C com=-Y Ls.*tan(pi/2.*fH./fL)/(2*pi*fH);
XI3=w.*R_p.*C_j'.*((Y_Ls+Y_Lo).*(-1+w.^2*L_p.*C_p)-w.*(C_p-
w.^2*L p.*C p.*C com+\overline{C} com\overline{)}.*cot(theta Ls)\overline{)};
X14 = (w.*C_j'+w.*C_p).*cot(theta_Ls) + (Y_Ls+Y_Lo+w.*C_com.*co)
t(theta Ls)).*(1-w.^2.*L p.*C p-w.^2.*L p.*C j');
X15=(Y Lo.*cot(theta Ls)-Y Ls.*tan(theta Lo)-w.*C com).*(1-
w.^2.*L_p.*C_p-w.^2.*L_p.*C_j')-(w.*C_j'+w.*C_p);
X16=-(Y_Lo.*(cot(theta_Ls))-Y_Ls.*tan(theta_Lo)).*w.*R_p.*C
j'.*(-Ī+w.^2*L p.*C p)-(w.^2*R p.*C j').*(Ē p-w.^2*L p.*C
\overline{p}.*C com+C com);
./(X15+j*X16);
S11Y HB=(Y0-Yin HB)./(Y0+Yin_HB);
mag \overline{HB} c=20*log\overline{10} (abs(S11Y H\overline{B}));
phase HB=rad2deg(unwrap(angle(S11Y HB)));
if phase HB(1,NP) > phase HB(V,NP)
    PSR \overline{HB} c=phase HB(:,:) - (ones(V,1) * phase HB(V,:));
else
    PSR HB c=phase HB(:,:) - (ones(V,1) * phase HB(1,:));
end
PSR HB=PSR HB c;
PSR HB L=max(abs(PSR HB c(:,F L)));
PSR HB H=max(abs(PSR HB c(:, F H)));
for i=1:V
   mag HB L c(i)=min(mag HB c(i,F L L:F L H));
    mag HB H c(i) = min(mag HB c(i, F H L: F H H));
end
mag HB L=min(mag HB L c(1:V));
mag HB H=min (mag HB H c(1:V));
for i=1:V
PD HB L c(i) = (max(PSR HB c(i, F L L:F L H))-min(PSR HB c(i, F
 L_L:F_L_H)))/2;
\overline{PD} HB \overline{H} \overline{c}(i) = (max(PSR HB c(i, F H L: F H_H)) - min(PSR_HB_c(i, F))
H<sup>L</sup>:F H H)))/2;
end
PD HB L=max(PD HB L c(1:V));
PD HB H=max(PD HB H c(1:V));
end
```